

L32 I-Line 光學曝光機 管理規則

115.07.13 修訂

1. 此機台開放等級為 **B2 級**，使用者經訓練且通過考核後方可自行操作。
2. 申請使用者須先通過 **TRACK 考核**，才可以申請考核 I-line 光學曝光機。一旦 TRACK 被停權，則同時取消 I-line 光學曝光機使用權。
3. 為維持委託代工出貨進度順暢，於上班時段 (上午 8 : 00 至下午 6 : 00) **TSRI 員工有優先使用權**。如欲在上班時段使用機台，必須先徵求現場代工人員同意之後，方可使用。
4. 每次使用須詳實填寫機台使用紀錄表，如有闕漏不實者，將視情節依 TSRI 規定議處。
5. 關於曝光後線寬的量測，由使用者自行操作 CD SEM 量測。
6. 曝光檔名請依命名規則，選擇搭配相對應的曝光內容。
7. 曝多層圖形，如果第一層為離子佈值阻擋層或蝕刻深度小於 100nm，請另行作零層曝光(TSRI 6W(4W/8W)PROD/20MM-STD-L0-6X6 (5X5/7X7)) 與蝕刻 (蝕刻深度大於 100 nm)。
8. 晶圓尺寸可為 SEMI standard 4(雙平邊)/6(單平邊)/8 吋(凹槽) 之不透光晶圓 或 25mm 破片，若為透光/半透光及其他基材，請洽詢工程師。
9. 此機台長駐 6/8 吋共用 chuck 曝光，且以 **6 吋曝光為主要服務**。若需 8 吋或 4 吋曝光服務，請詢問工程師。
10. 破片曝光者，需額外通過破片曝光考核，才可執行。破片曝光尺寸，最小需大於 25mm。
11. 標準製程光阻劑為 PFI38 阻劑(厚度 850 nm)、PFI89 阻劑(厚度 2100 nm) 、PFI245 阻劑(厚度 420 nm) 與 NLOR5510 阻劑(厚度 900 nm)。其中 PFI38、PFI89 與 PFI245 為正型阻劑，NLOR5510 為負型阻劑。非以上之阻劑請與洽詢工程師探討(需先提供 SDS)。
12. 塗佈完光阻的 4/6/8 吋皆需洗晶邊與洗晶背，且晶背需保持乾淨。
13. 本機台最小解析為 0.35 um L/S pattern、0.3um Line pattern 與 0.4um hole pattern，若有其他特殊需求請洽工程師。
14. 機台劑量設定範圍: 500 ~ 5000 J/M², focus 設定範圍: +2~-2 um.
15. 4/6 吋共用 chuck 曝光時, wafer 厚度容許範圍 350~850um. 6/8 吋共用 chuck 曝光時, wafer 厚度容許範圍 650~1150um.
16. 破片曝光時,須注意(載片+曝光片)的厚度需在容許範圍.
17. NA=0.63、σ=0.65(一般設定)，最小曝光劑量為 900J/M²。若需要低於此劑量，請通知工程師改設定(SIA mode)。